	формат	Зона	Поз		Обозни	74 <i>2H</i>	ue	Наименовани	IP	Кол.	Приме Чание
<i>ЮН.</i>								Конденсаторы			
примен				[1				КМ-5 0.1 мкФ ОЖО.460	0.043 TY	/	
. <i>Эдә</i> ј				<i>C2</i>				КМ-5 2200мкФ х 25В ОЖО.	460.043 TY	1	
11				<i>C3</i>				К50-6 47мкФ х 20В ОЖО.4	.64.107 TY	′	
	┢							Микросхема			
				D1				KP142 EH15A δK0.348.	634.01TY	/	
οN								Резисторы			
, ga				R1				M/1T-0,125 3k0M			
(U				R2				МЛТ-0,125 1.5кОм			
				R3				M/1T-0,125 10k0m			
				R4				M/IT-2 1 OM FOCT	7113_77	7	
	╁			R5				M/1T-0,125 1 KOM	112 11		
				R6				C173-10 470 oM 0X0.40		/	
Ш				R7				M/1T-0,125 47 OM			
и дата								Траизистори			
i U ō				VT1				Транзисторы КТ817Б NPN aA0.336	( 107 TL	/	
Подг				V / /				N 1017D NEW WAU.SSC	0.10713		
1удл.								Разъем			
No C											
Инв.	ullet										
B. No											
HI IH	$\vdash$										
эдл. Подп. и дата Взам. ин	_										
та	$\vdash$										
и дат											
<u>лба.</u>		Τ		1							<u> </u>
7	Из	M. //L	ורוח	№ докцм.	Подп.	Дата					
подл.	Po	Разраб. Самсонов П.С.				дили	устройство Вы	о Выхода выходного устроиства <u>Лит.</u>			Листов 1
VIHB. Nº		<u>Н.контр.</u> — Схема электрическая структурная ИСМА і Утв.						PT T	n.52132.		
Ho dao		коммерческого использования Копировал Формат						A4			